



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HS631K

对应国外型号
2SB631K

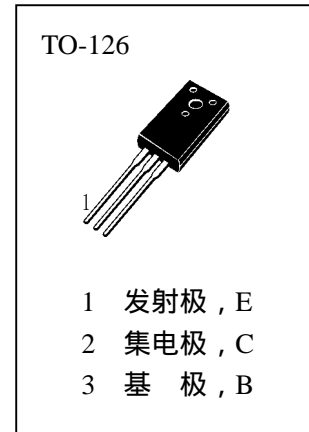
主要用途

低频功率放大、中速开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率 ($T_c=25$)	1W
V_{CB0} ——集电极—基极电压.....	-120V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-120V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-1.0A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CB0}	集电极—基极击穿电压	-120			V	$I_C=-10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-120			V	$I_C=-1mA, R_{BE}=\infty$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10\mu A, I_C=0$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			-1	μA	$V_{CB}=-50V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	μA	$V_{EB}=-4V, I_C=0$
$h_{FE}(1)$	直流电流增益	60		320		$V_{CE}=-5V, I_C=-50mA$
$h_{FE}(2)$	直流电流增益	20				$V_{CE}=-5V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		-0.15	-0.4	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压		-0.85	-1.2	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
t_{OFF}	关闭时间		100		ns	按特定测试电路
t_{STG}	贮存时间		600		ns	
t_F	下降时间		80		ns	
f_T	特征频率		110		MHz	$V_{CE}=-10V, I_C=-50mA$
C_{ob}	输出电容		30		pF	$V_{CB}=-10V, f=1MHz$

分档及其标志

D	E	F
60—120	100—200	160—320